



Toshiba lance des MOSFET de puissance à canal N 60 V et 100 V dans trois nouveaux boîtiers pour améliorer le rendement des circuits d'alimentation des équipements industriels

Cette nouvelle gamme utilise trois types de boîtiers : le SOT-23F polyvalent, le TSOP6F à dissipateur thermique et le compact UDFN6B afin de répondre à la demande croissante en systèmes d'alimentation 48 V et 24 V

Düsseldorf, Allemagne, 18 juin 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») a élargi sa gamme de MOSFET de puissance à canal N avec le lancement de neuf nouveaux composants, disponibles en trois types de boîtiers compacts à dissipation thermique élevée. La nouvelle gamme comprend trois produits de 100 V destinés aux circuits d'alimentation 48 V des équipements industriels et six produits de 60 V destinés aux systèmes 24 V.

Ces lancements répondent directement aux tendances actuelles du marché, où les circuits d'alimentation des équipements industriels passent des systèmes conventionnels 12 V et 24 V aux systèmes de 48 V afin de réduire la consommation d'énergie. Les courants d'appel et les surtensions sur les lignes 48 V pouvant entraîner une tension supérieure à 50 V (voire 80 V), des MOSFET conçus pour supporter 100 V sont nécessaires pour garantir un fonctionnement fiable. De plus, l'augmentation des tensions d'alimentation exige un rendement plus élevé, des pertes plus faibles et une réduction de la taille des composants. Pour répondre à ces tendances du marché, Toshiba a développé des produits compatibles avec les lignes 48 V et les lignes 24 V, qui sont actuellement les plus répandues.

Afin de répondre aux exigences variées des équipements industriels modernes, ces produits sont disponibles en trois types de boîtiers distincts. Les concepteurs privilégiant la polyvalence et la facilité de mise en œuvre peuvent utiliser le boîtier SOT-23F de 2,9 mm x 2,4 mm, offrant une dissipation de puissance de 1 W. Pour les applications nécessitant une dissipation de puissance plus élevée et une excellente dissipation

thermique, le boîtier TSOP6F est disponible à 1,5 W et mesure 2,9 mm x 2,8 mm. Pour les conceptions où la miniaturisation est essentielle, le boîtier UDFN6B offre une solution ultra-compacte et peu encombrante, avec une empreinte typique de 2,0 mm x 2,0 mm et une dissipation de puissance nominale de 1,25 W.

Malgré leur taille compacte, ces trois types de boîtiers présentent une faible résistance à l'état passant ($R_{DS(ON)}$), ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie des équipements. Cette combinaison de rendement élevé, de faibles pertes et de taille réduite compacité permet de nombreuses applications, allant des automates programmables industriels (PLC), des variateurs de fréquence/servomoteurs et des serveurs, jusqu'aux appareils électroménagers grand public tels que les ampoules LED, les chauffe-eau, les purificateurs d'eau et les aspirateurs robots.

Pour les lignes d'alimentation 48 V, Toshiba propose des MOSFET canal N de 100 V affichant une $R_{DS(ON)}$ de 198 m Ω :

[SSM3K387R](#) [SOT-23F]

[SSM6K387R](#) [TSOP6F]

[SSM6K387NU](#) [UDFN6B]

Pour les lignes d'alimentation 24 V, Toshiba propose des MOSFET canal N 60 V affichant une $R_{DS(ON)}$ de 99 m Ω :

[SSM3K388R](#) [SOT-23F]

[SSM6K388R](#) [TSOP6F]

[SSM6K388NU](#) [UDFN6B]

Pour les lignes d'alimentation 24 V, Toshiba propose des MOSFET canal N 60 V affichant une $R_{DS(ON)}$ de 200 m Ω :

[SSM3K389R](#) [SOT-23F]

[SSM6K389R](#) [TSOP6F]

[SSM6K389NU](#) [UDFN6B]

Toshiba continue d'élargir sa gamme de MOSFET à canal N afin de répondre aux besoins croissants du secteur industriel en solutions d'alimentation miniaturisées et à haut rendement.

###

À propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre aux consommateurs et aux entreprises d'Europe une grande variété de lecteurs de disques durs (*hard disk drive*, HDD) ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour l'automobile, l'industrie, l'IoT, le contrôle de mouvement, les télécommunications, les réseaux, la grande consommation et les produits blancs. Outre les disques durs, le vaste portefeuille de l'entreprise comprend des semi-conducteurs de puissance et d'autres composants discrets allant des diodes aux circuits intégrés logiques et aux semi-conducteurs optiques, ainsi que des microcontrôleurs et des produits standard spécifiques à l'application (*application specific standard products*, ASSP), entre autres. En outre, TEE propose

également des cellules et des modules de batterie SCiB™ avec de l'oxyde de lithium et de titane (LTO) pour les applications les plus exigeantes.

TEE a son siège à Düsseldorf, en Allemagne, et des succursales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni qui fournissent des services de marketing, de vente et de logistique.

Visitez les sites Web de Toshiba à www.toshiba.semicon-storage.com et www.scib.jp/en pour plus d'informations sur la société et ses produits.

Contact pour publication :

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0

Web : www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Contact presse :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe

Tél : +44 (0)7464 493526

E-mail : MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Pretzl

Tel: +49 (0) 172 617 8431

Web: www.pretzl.com

E-mail : birgit.schoeniger@pretzl.com

Juin 2026

Ref. 7669F